### ORGANIC ELECTROLUMINESCENT DEVICE HAVING INPROVED POWER CONVERSION EFFICIENCY

 Publication number:
 JP59194393
 Als → published

 Publication date:
 1984-11-05
 as:

 Inventor:
 SUCHIIBUN ARRANDO BANSURIKU; CHIYAN UON TAN
 ↑
 EP0120673 (A2)

 Applicant:
 EASTMAN KODAK CO
 ↓
 EP0120673 (A3)

 Classification:
 ↑
 EP0120673 (A3)

 - international:
 C09K11/05; H01L51/30; H01L51/50; H05B33/14; H05B33/2X;09K11/05; H01L51/50; H01L51/50; H01L51/50; H05B33/14; H05B33/2X;09K11/05; H01L51/50; H01L51/50; H05B33/14; H05B

(IPC1-7): C09K11/06; H05B33/14

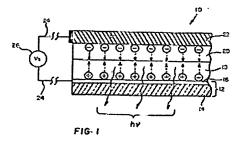
- european: H05B33/22; C09K11/06; H01L51/00M6F; H01L51/00M6H; H01L51/00M6H4; H01L51/50E; H05B33/14

Application number: JP19840058088 19840326
Priority number(s): US19830478938 19830325

Report a data error here

Abstract not available for JP59194393
Abstract of corresponding document: US4539507

Electroluminescent devices are disclosed comprising a hole-injecting zone and an adjacent organic luminescent zone, the device having a power conversion efficiency of at least 9x10-5 w/w and said zones having a combined thickness no greater than about 1 micron.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

### (9) 日本国特許庁 (JP)

① 特許出願公開

# ⑫ 公開 特 許 公報 (A)

昭59—194393

Mint. Cl.3 H 05 B 33/14 // C 09 K 11/06 識別記号

庁内整理番号 7254-3K 7215-4H 43公開 昭和59年(1984)11月5日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 12 頁)

❷改良された電力転換効率をもつ有機エレクト ロルミネツセント装置

创特

顧 昭59—58088

**22H** 

願 昭59(1984) 3 月26日

優先権主張 Ø1983年3月25日 日 (US)

**31478938** 

70発 明 者

スチープン・アーランド・バン スリク

アメリカ合衆国ニューヨーク州 14613ロチエスター市ピアーポ ント・ストリート324

**⑫発 明 者 チヤン・ウオン・タン** 

アメリカ合衆国ニユーヨーク州 14626ロチエスター市パーモン ト・ドライブ197

の出 原 人 イーストマン・コダツク・カン

> アメリカ合衆国ニューヨーク州 14650ロチェスター市ステート ストリート343

②代 理 人 弁理士 湯浅恭三 外4名

1. 〔発明の名称〕

改良された電力転換効率をもつ有機エレク トロルミネツセント装置

2. [ 特許請求の範囲]

顧吹陽極、正孔インジェクション帯域、有機 発光帯域(これらの帯域を合わせた摩さは 1<sub>4</sub>m を越えないし、および陰極からなり、

とれらの電極のうち少なくとも一方は400nm 以上の放長をもつ輻射線の少なくとも80%を 透過させるととができ、かつ

少なくとも9×10°W/W の電力転換効率を もつエレクトロルミネツセント袋筐。

3. (発明の詳細を説明)

本発明は、有機化合物を発光手段とする、電 気信号に応答して発光するエレクトロルミネン セント袋鹿に関する。

有機エレクトロルミネツセント装置がそれら の対抗品と十分に対抗しりるものとなるために は、対抗しらるコストにおいてそれらの重力転

換効率が増大するととが望ましい。電力転換効 率は入力に対する出力の比(通常はW/W)と 定義され、接近の枢動電圧の場故である。経済 的な駆動回路部品を用いる駆動単圧、すなわち 25ポルトを越えない 選圧に関しては、 魅力転 換効塞は無機停置の場合 1 × 1 0 W/W 以下に 限定されている。10。W/W 以上の電力転換効 率をもつ。厚いフィルム(> 5μm) または単 結晶を用いる有機エレクトロルミネッセント袋 進が開発されてはいる。しかしそれらの厚さが 比較的大きいため、との種の装成を駆動させる のに要する電圧はかなり高い、すなわち100 水ルトまたはそれ以上である。

駆動単圧を25ポルト以下に低下させるため には薄膜型エレクトロルミネッセント装置が望 ましい。これはことでは有効な帯域または層の 厚さ、すなわち電板間にある物質の厚さが1点点 を憩えない装崖を意味する。ピンホールの問題 を考えると薄膜の形態を達成することは特に困 離であった。ピンホールは電池をショートさせ

るので受入れられない。たとえばドレスナー、 RCAレビュー、Vol. 30, 322ff 頁 - (1969年6月)、特に326頁を参照され たい。ピンホールの形成を防止するために、被 獲用配合物中に結合剤を使用することが好都合 とされている。この雛の結合剤の例には付加重 合体たとえばポリスチレン。および縮合重合体 たとえばポリエステルが含まれる。電池のショ - トは縫けられるが、結合剤を使用するととは 不満足な場合がある。とのためには密剤被便加 工法を用いる必要があり、ある層の容別は下槽 の密剤としても作用する可能性があり、これに より借間の明瞭を境界設定が妨げられる。結合 剤を必要とする1階を溶剤被優したのち結合剤 を必要としない層(1倍または多層)を蒸着さ せる方法は考えられるが、逆の順序すなわち発 光谱を格剤被覆する場合、格剤が下槽化影響を 与えた場合の実用性は証明されていない。

米国幣許等4.556.429 号明細書に記載された戦池は、正孔インジェクジョン帯域

わせた厚さは1 um を越えない)、および悠復からなり。

とれらの電優の55少なくとも一方は400 nm 以上の波慢をもつ輻射線の少なくとも80%を 透過させることができ、かつ

少なくとも 9×10 W/W の職力転換効率をも つエレクトロルミネンセント装蔵が提供される。

(hole injecting zone)としてポルフィリン系化合物からなる層をもつ本発明のものと同じ型の装蔵の一例である。

上記等許のセルは先行技術のセルよりも著しい改良を示したが、望されている電力転換効率、すなわち25ポルトを越えない数動電圧を用いた場合に少なくとも9×10 W/W の水準を達成していない。正孔インジェクション層内のポルフィリン系化合物は有色であるため、セルにより放出される光を若干吸収するという望ましくない傾向を示す。またポルフィリン系化合物は有効に発光するために必要な正孔および電子の有効な発光的再結合を妨げると思われる。

本発明の目的は、少なくとも1桁改良された、 すなわち少なくとも9×10°W/W に及ぶ電力 転換効率をもつエレクトロルミネッセント(以 下"EL") 製備を提供することである。

本発明によれば、順次陽額、正孔インジェク ション帯域、有機発光帯域(これらの帯域を合

びろ)インジウム製陰傷から構成される。

本発明の装置は必要とされる改良された電力 転換効率を示す。

本発明の装置において発光帯域または正孔インジェクション帯域はそれぞれ電子伝達化合物からまたは正孔伝達化合物から作成され、これは本発明の実施線機の多くにおいてそれぞれの帯域に結合剤を用いずに行われる。

本発明のさらに他の有利な特色は、正孔イン ジェクション備用として、発せられた輻射線に 対し実質的に透過性である化合物が見出された ととである。

本発明の他の有利な特色は設付の図面を考慮 に入れて疑記の好ましい実施製機を参照するこ とにより明らかになるであろう。 朝1 図は電源 に接続した本発明装置の一部の気略的新面図で あり

第2図は本発明に従って製造された装置に騙する電力転換効率対エレクトロルミネンセント量子効率を示す対数一対数グラフである。

### 特開昭59-194393(3)

正孔インジェクション物質および発光物質は 各帯域内に存在するしとの帯域が層であっても 他のものであってもし。好ましいエレクトロル ミネツセントを瞳においてこれらの物質は源次 食なった被膜ないしは層中に存在する。

正孔インジエクション層は正孔伝達化合物か らなり、一方発光樹は電子伝達化合物からなる。 本発明者らは、後記のように駆動かよび構成 されるセルに用いた場合に5×10°光子/電子 を越えるEL爵子効率を与える特定の電子伝達 化合物があることを見出した。電力伝換効率と EL電子効率の間には直接的な関係があるので、 これらの化合物を用いると前記の収砂電圧に関 して眠力伝換効率は少なくとも9×10°W/W となることが保証される。これらの化合物は容 易に浮膜の形態で沈着するので、有効帯域を合 わせた厚さが1 um を越えない薄膜型袋崖が容 易に得られる。

本希明の装慮に用いられる電子伝導化合物は、 酸化量元反応において激元されりる化合物であ

物電圧をかけ、最大電子転換効率または25ポ ルトのいずれかに差するまでしいずれが先に起 とるとしても)高める。との鼈圧において最大 EL量子効率を測定する。

表しには、上記のように構成され、かつ上記 の風圧で収動される装筐において試験した場合 の若干の有用な電子伝達化合物に関するEL電 子効率を示す。これらの例のそれぞれにつき、 最大EL妻子効率の鼈圧は25ポルトの制限以 下であった。

る。本発明において特に有用なものは、前記の 試験に関して少なくとも5×10° EL量子効率 を与える電子伝達化合物である。周知のよりに BL看子効率は単純に外邪回路で創定される電 子/砂に対する、セルから放出される光子/砂 の比に等しい。との効率を成力転換効率(W/W の単位で定義されるりと漁問してはならない。

選子伝達化合物が少なくとも5×10 光子/ 電子(すなわち0.05%)のEL電子効果を与 えるか否かを判定するためには下記の試験を行

ELセルは下記の順序で構成される: 400 nm 以上の波提をもつ輻射線の少なくと も80.4を透過させる陽振[たと允はオザトロ ン(Nesatron、商牒) ガラス]; 本質的に 1, 1 - ピス(4 - ジ - p - トリルアミノフェニ ル)シクロヘキサンからなる正孔インジェクシ ン催;間額の電子伝達化合物の階;およびィ ンジウム製盤祭。ととで正孔インジェクション 層と発光層は合わせて厚さ1 4を越えない。収

第 1	東 大 * 関係点に対する じょうしゅうがある しゅうかん	'   .			$1(75_{am})/E1$ 1×10 20 v		-1(75nm)/E2 8×10 20v	3	-1(75nm)/E3 3×10 15v	•	-1(75nm)/E4 5×10 125V	•	.1(75nm)/E5 1.5×10 2 4 V	٠	.1(75nm)/E6 5×10 15v	, ,	1(75nm)/E7 8×10 14V	
	<del>1</del> 99	サトロン発摘/オパンドニジャン	(1500&)/インジケム(In 海鹿	( 孔教医 )	サトロン商家/HI-1 (75nm)/E1	(75nm)/Inna	ザトロン砂値/HI-1(75nm)/E2	(75nm)/In弱族	かトロン配像/田I-1 (75nm)/E3	(75nm)/In颗胞	ゲトロン郵流/HI-1(75nm)/E4	(75nm)/In凝集	ナトロン部第/HI-1(75nm)/ES	(75nm)/In階簡	がトロン砂桶/HI-1(75nm)/E6	(75nm)/In類像	ゲトロン部衙/HI-1(75nm)/E7	!!!!!

4かトロン配価/H

キナトロンB個/エ

を除って有効数子1個に四袖五入した。

2 HI - 1=1,1 - ビス(4-ジ-p-トリルアミノフェニル)シクロヘキサン

[ 4,4′- ヒス [ 5,7 - ジェーペンチル - 2 - ペンゾキサゾリル ] スチルペン]

4 E 2 =

【2,5~ピス【5,7~ダ~も~ペンチル~2~ペンゾキサゾリル】チオフェン】

5 E 5=

[2,2'-(1,4-フェレンジピコレン)ピスペングデアソール]

6 E4=

[ 2,2'-(4,4'-ピフェニレン)ピスペンソチアゾール]

7 E5= ピス(8-ヒドロキシキノリノ)マグネシウム

8 E6=

[2,5 - ピス[5 - (α,α - ジメチルペンジル) - 2 - ペンゾキサゾリル]チオフェン]

9 E7=

[25-ビス[57-ジ-t-ペンチル-2-ペンゾキサゾリル]-34-ジフェニルチオフエン]

ことで用いられる正孔インジェクション層の 正化伝達化合物は、電場を与えられた 2 個の電 徳間に配置されて関極から正孔がインジェクト された場合、正孔を適切に陰極へ伝達すること ができる化合あである。 好ましい正孔伝達化合 物は、10<sup>4</sup>~10<sup>8</sup>ボルト/cmの電場を与えられ を運転間に傾が配置された場合少なくとも10<sup>6</sup> ペ/ボルト - 秒の正孔移動係数をもつ。最も好 ましい正孔伝達化合物は容易にかつ可逆的に破 化されりる芳香族アミンであることが見出され た。

より好きしくは、正孔インジェクション値は 本質的に無色である。これは陽極に隣接した位 堂にあり、陽極は透明な電極であることが好き しい。従って正孔伝達化合物も400nm 以上 の波長において少なくとも90年透過性である ととが好ましい。

前記の光透過性をもつ有用な正孔伝達化合物 の好ましい例には、室温で固体であり、かつ少なくとも1個の設案原子が置換器でより置換さ

前記のように薄膜を形成しうる化合物の有用な例を以下に示す。 等に有用な例には複素環もしくは炭素膜、およびろ個以上の炭素膜子を有する脂肪族類少なくとも2個を含有するか、 あるいは少なくとも2個の基十なわちそれぞれ。) 一重結合の囲りに回転しつる基および。) 少なくとも3個の芳香族もしくは飽和炭素機を含む水を含有する化合物が含まれる。

れた(そのうち少なくとも1個はアリール巻きたは置換アリール基である)アミンが含まれる。アリール基上の有用な置換巻の例には、1~5個の設案原子をもつアルギル基、たとえばメチル基、エテル基、プロピル基、プチル基却よびアミル基;ハロゲン原子、たとえば塩果原子をよびフン果原子;ならびに1~5個の炭栗原子を有するアルコギン基、たとえばメトギン基、エトギン基、ブロポギン基、プテル基かよびアミル基である。

本発明に用いられる正孔伝達化合物のあるもの、および電子伝達化合物のあるものは、輝膜形成性化合物であるという付加的を性質をつことが注目される。ここで用いられるようにある化合物がこの物質を電板などの支持体上に 0.5 μm 以下の厚さで施した場合に " 薄膜形成性 " である場合、これは実質的に ビンホールを含まない質を形成する。しかしある化合物が薄膜形成性であるということは必ずしも 0.5 μm よりも多数に存在しないということを意味する

1,1-ピス(4-ジ-p-トリルアミノフェニル)シクロヘキサン;および次式の構造をもつ化合物

(上記式中nは2~4の整数である)。たとえば4.4-ビス(ジフェニルアミノ)クワドリフ

ェニル。

さらに他の有用な正孔伝達化合物には米国等 許部4.175,960号明細書13欄13行から 14編42行に列挙されたもの。たとえばピス (4-ジメチルアミノ-2-メチルフェニル) フェニルメタンおよびN・N・N-トリ(p-トリル)アミンが含まれる。

海腹形成性の電子伝達化合物に関しては、好ましい例には螢光増白剤が含まれる。最も好ま しいものは次式の構造をもつ歴光増白剤である。

これらの式中 R\*、R\* および R\* は別個化水果原子:1~10個の炭素原子を有する飽和脂肪族残善、たとえばプロピル基、 t - プチル基 およびヘブチル基:6~10個の炭素原子をするアリール基。たとえばフェニル基 および アナル基:あるいはハログン原子、たとえばは R\* と R\*、または R\* と R\* が一緒になって、1~10個の炭素原子を有する飽和脂肪族 授善した たくばメチル基。エチル基およびプロピル基)少なくとも1個を含んでいてもよい 縮合 芳香族 環を完成するために必要な原子を構成し、

R<sup>1</sup>は 1 ~ 2 0 個の炭素原子を有する飽和脂肪族 機態、たとえばメチル基、エチル基かよび n -アイコシル基: 6 ~ 1 0 個の炭素原子を有する アリール塩、たとえばフェニル基かよびナフチ ル基: カルボギシル基: 水素原子; シアノ基; あるいはハロゲン原子、たとえば塩素原子がよ びフン煮原子であり; ただし式 c) において R<sup>1</sup>. R<sup>4</sup> かよび R<sup>8</sup>のうち少なくとも 2 個は 3 ~ 10個の炭素原子を有する飽和脂肪炭機器。た とえばプロピル芸、ブチル芸またはペプチル基 であり、

Zは - O - 、 - NH - または - S - であり; Yは - R<sup>6</sup> + C H = CH + R<sup>6</sup> - 、

mはD~4の整数であり;

nは0.1.2±たは3であり;

R<sup>6</sup> は 6 ~ 1 0 個の炭素原子を有するアリーレン基、たとえばフェニレン基をよびナフチレン基であり;

R は水素原子または  $6\sim 10$  個の炭素原子を有するアリール基であり:そしてZ'およびZ'は別個にNまたはCH である。

上記の脂肪族残基は膛換されていてもよい。置

## 特閲昭59-194393(ア)

換された脂肪族残蓄の場合の腫換基には、1~5個の炭素原子を有するアルキル基、たとえばメチル基、エチル基かよびプロピル基;6~10個の炭素原子を有するアリール基、たとえばフェニル基かよびナフチル基;ハロゲン原子、たとえば塩素原子かよびフン業原子;ニトロ基;ならびに1~5個の炭素原子を有するアルコキン基、たとえばメトキン基、エトキシ基かよびプロポキン基が含まれる。

特に好ましい餐光噌白剤の例には下記のものが含まれる。2.5 - ピス(5.7 - ジー t - ペンチルー2 - ペンゾキサゾリル l - 1.3.4 - チアジアゾール; 4.4'-ピス(5.7 - t - ペンチルー2 - ペンゾキサゾリル) スチルベン; 2.5 - ピス(5.7 - ジーt - ペンチルー2 - ペンゾキサゾリル) チオフェン; 2.2'-(p-フェニレンジピニレン1 - ピスペンゾチアゾール; 4.4'-ピス(2 - ペンゾキサゾリル) ピフェニル; 2.5 - ピス[5 - (α.α - ジメチルペンジル) - 2 - ペンゾキサゾリル]チオフェン; 4.4'-

ピス(5,7 - ジー(2 - メチル-2 - ブチル)
-2 - ベンゾキサゾリル]スチルベン; および
2,5 - ピス(5,7 - ジー(2 - メチル - 2 - ブ
チル) -2 - ベンゾキサゾリル] - 3,4 - ジフ
ェニルチオフェン。

さらに他の有用な優光増白剤はケミストリー・オブ・シンセティック・ダイズ、1971、628~637頁がよび64日頁に列挙されている。すでに海膜形成性ではないものは、一端または両端の環に脂肪族の基を結合させることによって海膜形成性にすることができる。この種のさらに有用な登光増白剤には、たとえば下紀のものが含まれる。

[2- (2- [4- (2-ベンソイミダゾリル] フェニルトピニルトベンソイミダゾール]

[5-メチル-2-[2-[4-{5-メチル -2-ペングキサゾリル}フェニル]ピニル} ペングキサゾ-ル]

[ 2,5 - ヒス ( 5 - メチル - 2 - ベンゾキサゾ リル)チオフェン〕

[2-[2-(4-カルボキシフェニル]ビニル]ベンゾイミダゾ・ル] ⇒よび

[2-[2-(4-)ロルフェニルトビニル] ナフト[1,2-d]オキサゾール]

さらに他の有用な複膜形成性の電子伝達化合物には8-ヒドロギンギノリンの金属錯体が含まれ、その鉄金鍋は好ましくは2n-A8-Mg またはL1 である。

有効層の一方が薄膜形成性である場合、容易に認められるようにピンホールのため袋離がショートするととはないので、他方は樗膜形成性である必要はない。たとえば有用な袋離は、前記の薄膜形成性化合物からなる正孔インジェクション層、および檸膜形成性でない化合物、たとえば1,1,4,4 - テトラフェニル・1,5 - ブタジェンからなる発光管を含む。

前配の表しから明らかなように、有用な陽便 電磁には商牒"ネザトロン"のもとにPPG1

### 待開昭59~194393(8)

ンダストリーズ社から得られる被覆ガラス陽態 が含まれ、有用な陽低電極にはインジウムが含 まれる。一数のいかなる勝儼および陰憊もそれ が適切な仕事領政値をもつならば使用できる。 たとえば陽低は高い仕事製数をもつべきである。 他の有用な陽極の例にはいずれかの半透明な高 い仕事関数をもつ事電性材料、たとえば酸化ス メインジウム、酸化スズ、ニッケルまたは金で 被覆したガラスが含まれる。好ましくは、との 種の陽極は10~1000ォーム/スクエアー (ohms/square)のシート抵抗、および400 nm 以上の放慢に対し80多の光透過塩をもつ。 このように高い光透過密を少なくとも90まと いう正孔伝達化合物の透過塞と合わせた場合に、 本発明に従って作成された装置の特色である点 恋した電力転換効率が保証される。

他の有用な陰穏の例には低い仕事関数をもつ 他の金属、たとえば銀、スズ、鉛、マグネンウム、マンガンおよびアルミニウムが含まれる。 金属が毎世により発生するルミネンセンスに対 して高い透過率をもつか否かは関係ない。

明1四は本発明に従って製造されたエレクトロルミネッセント装置を示す。これは像化スズインジウムの半透明被膜16で被優されたガラス製支持体14からなる湯徳12を含む。この上に正孔インジェクション借18が配隆される。海18かよび20の一方または双方が薄膜形成性化合物である。陰徳22は備20上に配隆され、リードワイヤ24が接近を超減26に接続する。電源26を入れると帰徳12で発生した正礼は層18と20の界面へ伝達され、ここで陰徳22から伝達された電子と結合し、可視光線 b レ を発する。

電源26が接触10の最大出力点の電圧たと えば15~25ポルトで操作される場合、最大 眠力転換効率は少なくとも9×10 W/Wであ る。ある場合にはこの効率が2×10 に及ぶこ とが認められた。本発明の接触は改良された配 力気換効率の結果1700cd/元(500フィー

トランベルト)に及ぶ最大輝度を生じることが 駆められた。

本第明のEL製版は常法により作成される。 すなわち正礼インジェクション層、発光層かよび陰極をそれぞれ軽被被優法または蒸発により 施す。正礼インジェクション層が最初に形成で れることが好ましい。発光層に有用を密剤がで れインジェグション層に対しても良好な勝利がで ある場合、発光層を形成するためには蒸発が好 ましい。ここで用いられる"蒸発"には蒸発が好 からの沈滑のあらゆる形態が含まれ、真空下で 行われるものも含まれる。

下配の実施例により本稿明をさらに説明する。 とれらの実施例において最大輝度は不可逆的改 壊を生じる選圧のすぐ下の選圧で即定される。 若干の実施例において収動選圧について25V という好ましい吸変を越える輝変に関する選圧 が示されているのはこのためである。

#### 寒胞例 1

男1図のものと類似したエレクトロルミネッ

セント装置(以下"セル")を以下により製造 した。

1) 陽標を作成するため、ネザトロンガラスをまず 0.05 μm アルミナの研摩材で数分間研磨した、次いでイソプロピルアルコールおよび蒸留水の1:1(V)混合物中で超音波清浄した。次いでこれをイソプロピルアルコールですすぎ、鑑業で送風乾燥させた。最後に、使用前にこれをトルエン中で超音波清浄し、鑑業で送風乾燥させた。

2) 1,1-ビス(4-ジ-p-トリルアミノフェニル)シクロへ中サン(HI-1)をネザトロンガラス上に一般的な真空蒸漕法により沈漕させた。すなわち上記物質を電気的に加熱されたタンタル資ポートから320℃の感度で5×10°トルの系内圧力にかいて蒸発させた。ネザトロンガラスに沈着した生成HI-1フィルムの厚さは75nm であった。

3) 次いで4.4'-ピス(5.7 - ジ- t - ペンチルー2 - ペンゾキサゾリル)スチルペン(E1)

を 21 に記載したと同じ手法を用いて、ただし供給源温度 3 5 0℃を採用してH I - 1 増の上船に沈着させた。E1層の厚さも 7 5 nm であった。

4) 次いでインジウムをE1フィルムの上部に シャド-マスクを介して沈滑させた。 In 電極 の面積は D.1 cmであり、これもエレクトロルミ ネッセントセルの有効面積を規定した。

出来上がったセルはネザトロンガラス電額をプラスとしてバイアスをかけた場合、青緑色の光を放出した。放出された光は520nm に最大放出を有していた。達成された最大輝曜は与えられた曜田が22Vである場合、電旅密曜140mA/cdにおいて340cd/㎡であった。20Vで駆動した場合、最大電力転換効率は1.4×10<sup>-3</sup>W/Wであり、最大エレクトロルミネッセント量子効率は1.2×10<sup>-2</sup>光子/電子であった。

#### 哭鲍例2

檸膜形成性でない正孔インジエクション層の

20 ポルトで駆動した場合、最大電力転換効率は $8.1\times10^4$  W/W であり、最大E L 電子効率は $6.9\times10^3$  光子/量子であった。

これらの結果は、発光層が薄膜形成性化合物 からなるためピンホールを含まないならば正孔 インジェクション僧は薄膜形成性でなくてもよ く、また結合剤を含有しなくてもよいことを証 明している。

### 実施例3

#### 発光層用の他の物質

実施例1と同様化してエレクトロルミネンセントセルを製造した。ただし下記の優光増白剤を発光階として用いた。

[ 2,5 - ビス ( 5,7 - ジ - t - ベンチル - 2 -ベンソキサゾリル ) - 1,3,4 - チアジアゾ - ル]

#### 使用

実施例 1 に記載したようにエレクトロルミネ ツセントセルを製造した。ただしN . N . N -トリ(p-トリル)アミンを正孔インジエクション催としてHI-1の代わりに使用した。こ のアミンは次式の構造をもつ。

セルは実施例1に記載したものと同じ方法で 製造された。ただしアミン蒸発のための供給源 温度は120でであった。厚さは75 nm であった。このセルに30 Vをかけた場合。電流密 度40 mA/cはおよび最大輝度102 cd/㎡ が 得られた。放出された光はこの場合も青緑色で あり、520 nm に最大放出を有していた。

実施例1と同様にしてセルを製造した。ただし髪光増白剤の蒸発のための供給原温度は260でであった。放出された光は橙色であり、590nmに最大放出を有していた。得られた最大様度は30Vかよび40mA/cdにかいて340cd/パであった。20Vで駆動された場合、最大電力転換効率は1.5×10<sup>®</sup>W/Wであり、最大EL量子効率は1.4×10<sup>®</sup>光子/数子であった。

#### 発光層用の他の物質

実施例1と同様にしてエレクトロルミネッセントセルを製造した。ただし2.2-(p-フェニレンジピニレン)ピスペンゾチアゾール(E3)を発光槽として用い、300℃で蒸発させた。

E 3

とのセル(ネザトロン/HI-1/E3/In)

は緑色の光を放出し、これは  $560\,\mathrm{nm}$  に最大 放出を有していた。得られた最大輝度は  $1.7.5\,\mathrm{V}$  かよび  $200\,\mathrm{mA}/\mathrm{cd}$  において  $340\,\mathrm{cd}/\mathrm{m}$  で あった。  $15\,\mathrm{V}$  で 堅動した場合、最大 電力 転換 効率は  $4\times10^4\,\mathrm{W}/\mathrm{W}$  で あり、最大 エレクトロルミネッセント 量子効率は  $3\times10^4\,\mathrm{光子}/\mathrm{量子}$  で あった。

#### 実施例5

### 発光槽用の他の物質

前配実施的 1 と同様にしてエレクトロルミネンセントセルを製造した。ただし2 - (4 - ピフェニル) - 6 - フェニルペンゾキサゾール(PBBO)を発光値として巨1の代わりに用い、200℃で蒸発させた。

このセル(オザトロン/HI-1/PBBO/In)は白青色の光を放出した。得られた最大輝暖は25Vかよび50mA/cd にかいて34cd/㎡であった。20Vで駆動した場合、最大電力転換効率は9.5×10 W/W であり、最大エレクトロルミネッセント量子効率は8×10 光子/電子であった。

#### 実施もおよび7

#### 発光層用の他の物質

実施例1と同様にしてエレクトロルミネッセントセルを製造した。ただし発光層はE1の代わりに2,5 - ピス[5 - (α,α - ジメチルベンジル) - 2 - ベンゾキサゾリル]チオフエン(実施例6)かよび2,5 - ピス[5,7 - ジーセーベンチル - 2 - ベンゾキサゾリル] - 3,4 - ジフェニルチオフェンからなり、340℃の温度で蒸発させた。表』に結果を示す。

	砂罨側定 販動 調力	15v	1 4 V
	海 田 田 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	5×10 <sup>3</sup> 電子/電子	1.4×10 8.4×10 W/W 表子/電子
1.	高 の を を を を を	7×10 W/W	1.4×10 W/W
**	<b>吹車</b> 大 度	680cd/m² (19V5LG .150mA/di .K&v.T.)	1700ed/# (20V±x& 300mA/d %cent)
	成故	530 <sub>nm</sub>	*
	<b>40</b> )	<b>₫</b>	•
	<b>5</b>	<b>~</b>	~

### 突施例8

### 薄膜形成性でない電子伝達化合物

実施例1と同様にしてエレクトロルミネッセントセルを製造した。ただし、1,1,4,4 - テトラフェニル - 1,3 - ブタジエン(TPB)を発光層として用いた。

TPB昇華のための供給源温度は210℃であった。とのセルは育色の光を放出し、これは450nm に最大放出を育していた。得られた輝度は20 V かよび200mA/od において102cd/m であった。15 V で駆動した場合、最大電力伝換効率は2×10 W/W であり、最大エレクトロルミネッセント電子効率は1.2×10 光子/電子であった。このセルは蒸発したTPB

### 特爾昭 59-194393 (11)

の構造をもつピスし8~ヒドロキシャノリノ)

マグネンウムをそれぞれ発光層として用いた。 操作条件は実施別1の配載と同様であった。た

だし金属錯体の供給原温度はそれぞれるる○℃

(実施例9)かよび410℃(実施例10)で

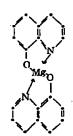
あった。袋罩に結果を示す。

層の不均質なかつ薄膜形成性でない性質にもかかわらず機能した。TPB僧は顕敬鏡下で見た 場合小さなクラスターのモザイクの外観を有し ていた。

### 実施例タおよび10

電子伝達化合物として8-ヒドロキシキノリグ の金減錯体を使用

実施例1と同様にしてエレクトロルミネンセントセルを製造した。ただしビス(8-ヒドロキシキノリノ)アルミニウム(実施例9)、および次式



/ 単統例1.0

上記各実施例に示した効率を便宜のため第2 図にプロットした。第2図の点線は傾向を示す にすぎず、いずれかの方法による最適なものを 表わすものではない。そとに示されたデータは 傾係式

BOS(電力転換効率)= BOS(EL量子効率)+BOSK (上記式中Kは切片(intercept) であり、
駆動電圧によって一部制御される係数である)
に従うとほぼ直線状である。駆動電圧(第1図の電源26)の値が上がるのに伴って、第2図の曲線は下方へ移動する。従ってより高い駆動 電圧では、同一のEL電子効率でも、もはや希望する9×10W/W の電力転換効率を与えないようになるであろう。

### 4. [ 図面の簡単な説明 ]

第1図は覚測に接続した本希明装置の一部の 数略的新面図であり、

第2回は本発明接近に関する電力転換効率対 エレクトロルミネッセント電子効率を示す対数 - 対数グラフである。

	<b>网络</b>	15V	24V
	事である。大いの事がいる。	5.8×10³ 光子/程子	1.5×10°
	級 大 職 力 医缺少率 ( M / W )	82×10*	1.4×10
英	表籍。 大解(=(-q/2)	340 (15V3-LG 50mA/cd	でかって! 340 (24Vおよび 100mA/al において)
	数田数田なれるれたので設定	515nm	548nm
	なな。まな、田田では、田田では、田田では、田田では、田田では、田田では、田田では、田田で	袭	**
	光路	٥	0

図中の各配号は下配のものを表わす。

10:エレクトロルミネツセント 袋費;

12:陽極; 14:ガラス製支持体;

16:半透明被膜;

18:正孔インジェクション槽; 20:発光槽;

22: 路框: 24:リードワイヤ;

26:道源。

海杵出版人 イーストマン・コダック・カンパニー

代 强 人 弁理士 湯 浅 恭 三 (外4名)

